

9014S

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4")

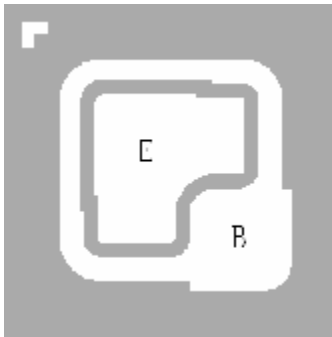
■ 用途

- *小信号放大器
- *高增益、低噪声音频驱动器

■ 特征

- *优越的 h_{FE} 特性
- *低噪声
- *与 9015S 配对
- *集电极电流: 0.1A
- *有效管芯数(只):78800

■ 芯片示意图



■ 芯片结构

| | |
|-------|---|
| 芯片尺寸 | 300 μ m \times 300 μ m |
| 压焊区尺寸 | 基区 88 μ m \times 88 μ m 发射区 88 μ m \times 88 μ m |
| 芯片厚度 | 200 \pm 10 μ m |
| 锯片槽宽度 | 40 μ m |
| 金属层 | 正面:Al 1.85 \pm 0.15 μ m 背面:Au 1.1 \pm 0.2 μ m |

■ 电特性(Ta=25°C)

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|--------------|---------------|------------------------|----|------|----|
| 集电极--基极击穿电压 | BV_{CBO} | $I_C=100 \mu A, I_E=0$ | 50 | | V |
| 集电极--发射极击穿电压 | BV_{CEO} | $I_C=1mA, I_B=0$ | 45 | | V |
| 发射极--基极击穿电压 | BV_{EBO} | $I_E=100 \mu A, I_C=0$ | 5 | | V |
| 集电极--基极截止电流 | I_{CBO} | $V_{CB}=45V, I_E=0$ | | 200 | nA |
| 发射极--基极截止电流 | I_{EBO} | $V_{EB}=4V, I_C=0$ | | 200 | nA |
| 直流电流增益 | h_{FE} | $V_{CE}=5V, I_C=1mA$ | 60 | 1000 | |
| 集电极--发射极饱和电压 | $V_{CE(SAT)}$ | $I_C=100mA, I_B=5mA$ | | 0.3 | V |